МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Физический факультет

Кафедра физики полупроводников

Егоров Дмитрий Александрович

КУРСОВАЯ РАБОТА

**Особенности магнетосопротивления полупроводниковых микроструктур, обусловленные эффектом магнитной фокусировки**

3 курс, группа №20344

**Научный руководитель**: к.ф.-м.н. Д.А. Похабов

Оценка научного руководителя

« » мая 2023 г.

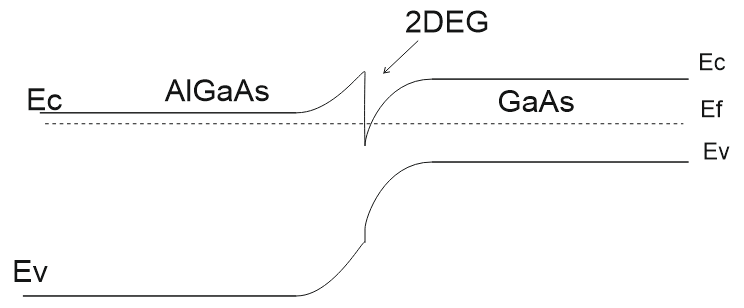
Новосибирск 2023

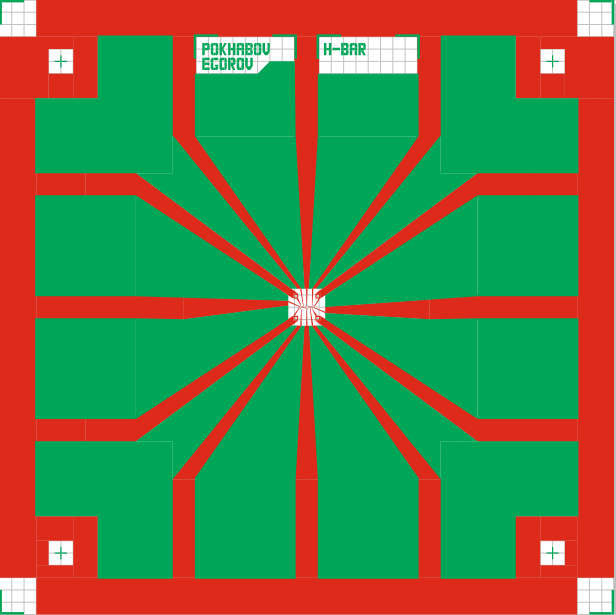
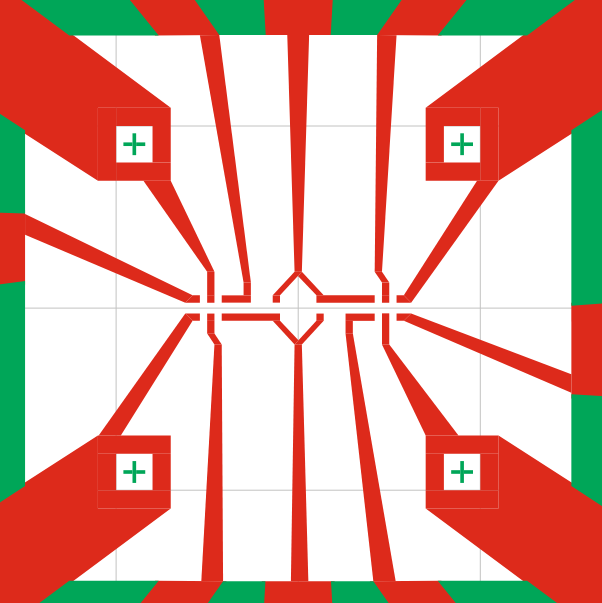
**Аннотация**

**Оглавление**

1. **Введение**

**Образцы**

Изготовление образцов производилось выращиванием гетероструктур AlGaAs/GaAs с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии.  При сближении полупроводников, образующийся пространственный заряд приводит к изгибу электронных зон. На полупроводниковой гетерогранице появляется область с пиком электронной плотности, а движение электронов перпендикулярно границе запрещено энергетическим барьером. Такая система называется двумерным электронным газом (ДЭГ). Двумерная концентрация электронов в ДЭГ исследуемых образцов была измерена методом ван дер Пау и составляла (!).

Для создания геометрии в ДЭГ использовался метод фотолитографии.  Гетероструктура была разбита на квадратные образцы со стороной 2,5 мм. Каждый образец состоял из 12 проводящих областей, сужающихся к центральной области. В центре образца формировалась геометрия, для изучения магнетосопротивления. На рисунке () показана геометрия одного из изготовленных образцов. Белые области на рисунке - двумерный электронный газ, красные – вытравленные непроводящие области, зеленые – проводящие области, примыкающие к ДЭГ. Такая геометрия подходит для различных измерений: продольного сопротивления, холловского сопротивления, нелокального сопротивления. Ширина контактов составляла от 2 до 6 мкм.  Характерное продольное сопротивление между парой контактов составляло 1 кОм.

Использованный метод фотолитографии позволяет задавать геометрию образца с разрешением 1 мкм.

Ко внешним, наиболее широким проводящим частям образца припаивались металлические контакты, в дальнейшем используемые для измерений.

**Методика измерений**

Для исследования магнетосопротивления в двумерном электронном газе необходимы низкие температуры. Тепловое движение электронов полностью размывает необходимые эффекты при приближении к 80 K.

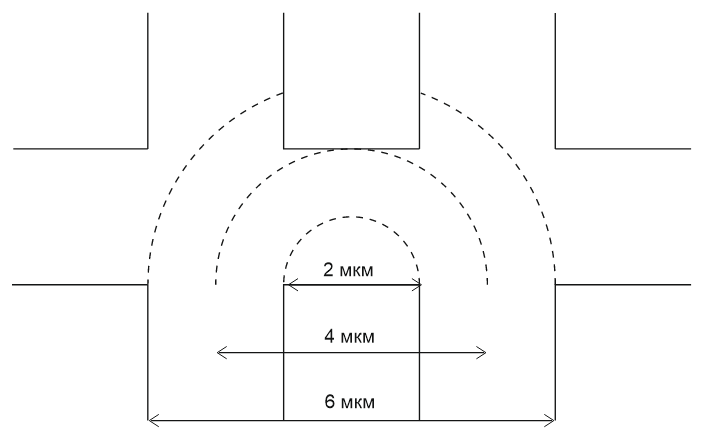
При проведении эксперимента, серии данных были записаны при различных температурах от 1,6 до 80 К.

Установка позволяла проводить измерения магнетосопротивления в магнитных полях до 12 тесла. Прикладываемое переменное напряжение составляло 1 В.  Отклик в виде тока измерялся методом синхронного детектирования.

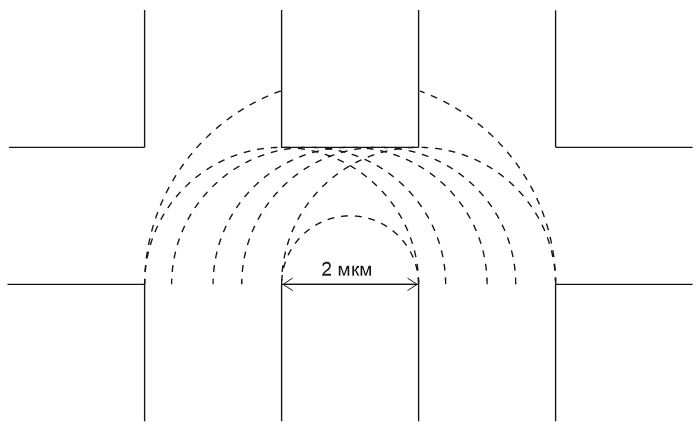
Образец погружался в низкотемпературную камеру с проводами, протянутыми от него через трубку к синхронному детектору. В течении длительного времени в камере устанавливалась температура 1,6 К. Проверка корректности работы всех контактов производилась двухточечным измерением сопротивления каждой пары контактов. При таком измерении наличие большого сопротивления (относительно других пар контактов) или большой фазы получаемого сигнала указывает на неисправность контакта.

Измерения проводились по четырем точкам: на два контакта подавалось переменное напряжение и с двух контактов снимался ток. Магнитное поле медленно менялось, а получаемый сигнал усреднялся по времени синхронным детектором для уменьшения погрешности. После записи каждой кривой, температура в камере изменялась и измерения производились вновь.

**Баллистические траектории**

Эффекты, связанные с магнитной фокусировкой, обусловлены наличием баллистических траекторий между контактами. В качестве примера рассмотрим траектории, возникающие в геометрии в виде холловских мостиков.

Расстояние между контактами и ширина контактов совпадают и равны 2 мкм. Также, для определенности, будем рассматривать электроны, вылетающие из контакта под прямым углом.

Пусть переменное напряжение U прикладывается к контактам 1-2, а ток I снимается с правых двух контактов 3-4. В отсутствии магнитного поля ток I полностью отсутствует, так как ток между контактами 1-2 никак не влияет на контакты 3-4. При включении магнитного поля, электроны начинают двигаться по круговым орбитам и при некоторой величине поля попадают в 3-й контакт. Необходимо заметить, что в действительности на движение электронов влияет наличие верхней стенки, ограничивающее возможные траектории по диаметру. При дальнейшем увеличении магнитного поля диаметры будут уменьшаться и при некоторой величине поля диаметр станет минимально возможным для беспрепятственного пролета электрона между контактами, то есть равным расстоянию между контактами.

Рассмотрим вклады вышеописанных траекторий в суммарный ток. Как видно из рисунка, траектория с минимально возможным диаметром всего одна: от края одного контакта, до края другого. Таким образом ее вклад минимален. Траектория с диаметром 4 мкм. (расстояние между центрами двух контактов) имеет наибольший вклад, так как электроны с такой траекторией доберутся до другого контакта вне зависимости от исходной координаты вылета. Траектории с большим диаметром могут дать вклад в ток лишь с учетом рассеяния на стенках.

Из описанных рассуждений можно ожидать пик в магнетосопротивлении при значении магнитного поля соответствующего траектории с диаметром 4 мкм.